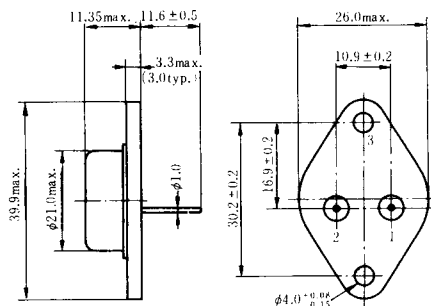


2SD1094

シリコン NPN 三重拡散形
高電圧電力スイッチング用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED
HIGH VOLTAGE POWER SWITCHING



1. ベース: Base
 2. エミッタ: Emitter
 3. コレクタ: Collector
(ケース) (Case)
- (Dimensions in mm)

(JEDEC TO-3)

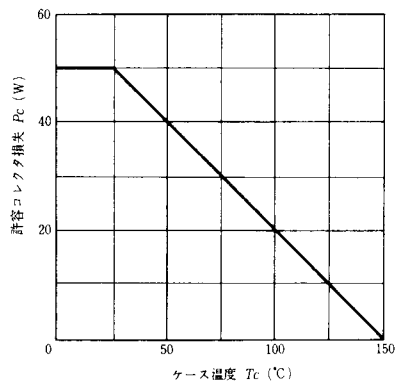
■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

項目	Symbol	2SD1094	Unit
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CES}	1000	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	400	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	6	V
コレクタ電流	I_C	10	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$	15	A
許容コレクタ損失	P_C^*	50	W
接合部温度	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-45 ~ +150	$^{\circ}\text{C}$

* $T_c=25^{\circ}\text{C}$ における値

* Value at $T_c=25^{\circ}\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10\text{mA}$, $R_{BE}=\infty$	400	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10\text{mA}$, $I_C=0$	6	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CES}	$V_{CE}=1000\text{V}$, $R_{BE}=0$	—	—	500	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}$, $I_C=2.5\text{A}^*$	15	—	—	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C=4\text{A}$, $I_B=0.8\text{A}^*$	—	—	1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(\text{sat})}$	$I_C=4\text{A}$, $I_B=0.8\text{A}^*$	—	—	1.5	V
下降時間	t_j	$I_C=4\text{A}$, $I_{B1}=0.8\text{A}$, $I_{B2}=-1.2\text{A}$	—	—	1.0	μs

*パルス測定

* Pulse Test